高周波デバイス測定用テストフィクスチャ

Test Fixture for High Frequency Device Measurement

UDC 621.316.8 + 621.318/.319: 621.317.799

鈴木文和	Fumikazu Suzuki	計測器事業本部	計測器事業部	計測システム開発部
山岸祐一	Yuichi Yamagishi	計測器事業本部	計測器事業部	計測システム開発部

1 _{ສາ.}1

近年の電子機器は高機能化,高集積化,小型化の一途をた どっており,これに貢献しているのが半導体デバイスの高密 度実装技術,パッケージ技術である。半導体デバイスは,プ ロセスのサブミクロン化,配線の多層化により高集積化して おり,半導体パッケージにおいても,BGA (Ball Grid Array) 技術等により端子ピッチの縮小・表面実装化,多ピン化を実 現している。

図1に示すプラスックパッケージ外形の動向に示すように, DIP (Dual Inline Package)から発達した半導体パッケージは, 多ピン化のQFP (Quad Flat Package),小型化のSOP (Small Outline Package), SSOP (Shrink Small Outline Package)など で高密度実装を実現している。



図1 プラスチックパッケージ外形の動向 Trend of plastic package

このような多ピン化,狭ピッチ端子化された半導体デバイ スは,PDC・PHS等の移動体通信デバイスとしても用いられ 移動通信端末の小型化に寄与している。また,移動通信の急 激な進展に伴って準マイクロ波帯およびマイクロ波帯の利用 が図られ高周波化している。

この高周波デバイスは,性能保証のため高周波かつ小型デ パイス対応のテストフィクスチャ(測定治具)が必要であり, 自動化された生産ラインで使用されるため高周波測定装置の 高再現性 , 耐久性が要求される。

このような要求に応えるため当社では,これまでSOP対応 (端子ピッチ1.27mm以上)でDC~6GHzの周波数範囲をもつ ME0100シリーズのテストフィクスチャを提供している。表1 にME0101A,表2にME0104Aテストフィクスチャの主要性能 を示す。今回は新たにSSOP(Shrink Small Outline Package) 対応(端子ピッチ0.5mm以上)でDC~8GHzの周波数範囲を もつMU740000シリーズのテストフィクスチャを開発したの で,その設計方針,設計の要点,主要性能について述べる。 図2にMU740000テストフィクスチャの外観を示す。



図2 MU740000 テストフィクスチャ外観 External view of MU740000 test fixture

2 _{設計・開発方針}

今回, MU740000シリーズのテストフィクスチャを開発する に当たり,市場要求を調査するため,顧客数社と情報交換を 密にし試作品のユーザエバレーションを実施して問題点の早 期改善を図るように計画した。

表1 ME0101A テストフィクスチャの主要規格 Specification of ME0101A test fixture

国动物资用		DC ~ 6GHz				
同波致軋曲	1GHz	3GHz	6GHz			
インピーダンス	50					
リターンロス*1	20dB以上	15dB以上	10dB以上			
挿入損失*2	1dB以下	1.5dB以下	2dB以下			
アイソレーション	80dB以上 ^{*3} 60dB以上 ^{*4}	70dB以上 ^{*3} 60dB以上 ^{*4}	70dB以上 ^{*3} 30dB以上 ^{*4}			
再現性 ^{*5}	± 0.05dB	± 0.1dB	± 0.1dB			
寿命 ^{*6} (参考値)	入出力コンタクト:100万回(デバイス端子が金メッキの場合) アースコンタクト:10万回(消耗品,交換可能)					
測定系校正基準面	入出力SMAコネクタを基準面とする校正					
コネクタ	SMA					
環境条件	温度:15~35 ,湿度:40~70%					
寸法 ^{*7} ・質量 ^{*7}	30H × 170W × 100Dmm,600g以下					

規格(測定条件:入出力SMAコネクタを基準面とした2ポートOSL校正による)

*1:スルーキットを挿入したテストフィクスチャで入出力総合を評価

*2:スルーキットを挿入したテストフィクスチャ入出力間の挿入損失

*3:入出力の接点端子間が4mm以上で,入出力接点がオープン

*4:入出力の接点端子間が3mm以上で,入出力接点がオープン

*5:スルーキットを用いて,S21を30回測定したデータから求めた2 値で規定

*6:マニュアル操作の場合は除く

*7:マニュアル用デバイスの押え治具は除く

表2 ME0104A テストフィクスチャの主要規格 Specification of ME0104A test fixture

規格(測定余件:八山川SMAコイクタを基準囲としに 2 小一 FUSL 校正による	:基準面とした2ポートOSL校正による	を基準面と	入出力SMAコネクタ	(測定条件	規格
---	---------------------	-------	------------	--------	----

周波数範囲	DC ~ 2GHz
インピーダンス	50
リターンロス*1	20dB以上
挿入損失*2	1dB以下
アイソレーション*3	50dB以上
許容最大電流	3A
再現性*4	±0.1dB以下
寿命*⁵(参考値)	入出カコンタクト:10万回(デバイス端子が金メッキの場合。交換可能) 電 源 コン タク ト:10万回(デバイス端子が金メッキ,各コンタクトは交換可能) アースコンタクト:10万回(デバイス端子が金メッキ,交換可能)
測定系校正基準面	入出力SMAコンタクトを基準面にした校正
コネクタ	SMA
環境条件	温度:15~35 ,湿度:40~70%
寸法 ^{*6} ・質量 ^{*6}	50H × 120W × 140Dmm , 1.0kg以下

*1:スルーキットを挿入したテストフィクスチャで,入出力総合の値

*2:スルーキットを挿入したテストフィクスチャ入出力間の値

*3:接点端子間が7mm以上で,入出力がオープン

*4:スルーキットを用いて,S21(3dB以内)を30回測定したデータから求めた2 値で規定

*5:マニュアル操作の場合は除く

*6:マニュアル用押え治具は除く

以下に設計の狙いについて主な点を述べる。

(1) 高周波特性

移動通信(動作周波数:~2.5GHz)の高周波デバイス (AMP, MIX, Switch)をターゲットデバイスとし,動作周波 数の2~3倍波の特性評価を望んでいる顧客要求に応えるため テストフィクスチャの周波数範囲はDC~8GHzとし,特性イ ンピーダンスは50 ,反射減衰量は20dB/2GHz,15dB/8GHz を目標性能とした。

(2)対象パッケージ

対象パッケージは,今後主流となるSSOPとし,リードピッ チは3種類(0.5mm,0.65mm,0.95mm),リード数はMAX28 本/0.5mm,MAX20本/0.65mm,MAX6本/0.95mmとして,ほ とんどのターゲットデバイスについて対応できるようにした。

(3)繰り返し再現性・耐久性

テストフィクスチャは量産ラインの検査工程で使用される ため,繰り返し再現性・耐久性の高性能が要求される。

当社の ME0100 シリーズテストフィクスチャの市場実績, およびデバイスリードのメッキがAu メッキではなくはんだメ ッキである現状から,繰り返し再現性は±0.1dB(2),耐久 性は30万回(対はんだメッキ)を目標性能とし,かつテスト フィクスチャの接触部は交換が容易にでき,交換再現性の良 好な構造を目標とした。

(4) Active Device 対応

Active Device (Power Amp等)の測定は,デバイスのイン ピーダンス整合のためL,Cチップ部品を搭載した整合回路を テストフィクスチャに付加する必要がある。この時,デバイ ス端子からチップ部品までの距離は極力短いことが望まれる。 この距離は少なくとも動作周波数の波長に対して1/20以下 (6mm/2.5GHz)でないと,整合回路が集中定数として扱えな いため,今回は2mm以下を目標にした。

(5) メンテナンス性

繰り返し再現性・耐久性の項でも述べたようにテストフィ クスチャの接点部は消耗品である。この消耗品交換において は,交換再現性が良好であるとともに,交換作業性が簡単で, かつ交換時間が短いことも要求される。そこで,交換部品点 数は2点以内,交換時間は15分以内を目標とした。

3 設計の要点

現状の ME0100 シリーズテストフィクスチャは, SSOP デバ イスを対象とすると,以下のような問題点があった。 ・接点構造が板ばね式であるため,接点部と整合回路間の 距離が長くなり(20mm以上), Active Device 対応が難しい。

・デバイスリードがはんだメッキの場合,耐久性が約1万回である。

·狭ピッチ対応ができない。(1.27mm以上)

また,市販のICソケット方式や,整合回路を組み込んだプ リント板方式のテストフィクスチャは,構造がシンプルで安 価であるという特徴があるが,高周波化の限界,繰り返し再

表3 テストフィクスチャ各方式の比較 Comparison of test fixture

	ME0100 シリーズ	ICソケット 方 式	プリント板 方 式	MU740000 シリーズ
0.5mmピッチ対応	×			
測定再現性			×	
Active Devece対応		×		
メンテナンス性			×	
高周波対応		×		
データ相関性	×	×		

現性・耐久性が悪い等の問題点があった。各方式の比較表を 表3に示す。

以下に,それぞれの問題点の解決方法について述べる。

(1) Active Device 対応

現状のME0100シリーズテストフィクスチャの接点部構造 は、セラミックを用いた片持ちばね構造で、デバイス電極の 高さ方向のバラツキを吸収し、かつ接触時の衝撃力を緩和で きるとともに接触安定に必要な接圧を加えることで良好な繰 り返し再現性を実現している。しかし、板ばねは材料強度か らある長さを必要とし、接点部と整合回路までの長さは短く するのに限界があった。

そこで,接点部と整合回路までの長さを短くし,かつ良好 な繰り返し再現性を実現するために新接点部構造を開発した。 概略図を図3に示す。

この新接点部構造は,デバイス端子と整合回路用チップ部 品が搭載されたプリント板の間に接点材が挟み込まれている 構造になっていて接点材上面でデバイス端子と,接点材下面 でプリント板のパターンエッジと電気的に接続される。

また,整合回路までの長さについても,接点材のスペース が約0.8mm しかないため,絶縁シート分を考慮しても約 1.5mm となり,目標値2mmを十分下回ることができた。 デバイス装着前



(2) 繰り返し再現性・耐久性

はんだメッキに対する繰り返し再現性・耐久性を向上させ るためには,転移(はんだが対接触面に移転する現象)の影 響を低減する必要がある。

この転移を防止することは非常に困難であるが,転移しず らいようにはんだメッキされたデバイス電極面とテストフィ クスチャ接点部を積極的に摺動させるようにした。これは, 図3の新接点構造概略図に示すようにデバイスを装着した時, 接点材はプリント板パターンのエッジを支点として回動する ため摺動する。また,これまでの実績からテストフィクスチ ャ接点部はNiメッキが有効であると確認できているため,こ の対策も施した。はんだメッキとNiメッキとの接触は,接触 安定に必要な接圧が約25g以上であるため,製造バラツキ等 を考慮して30~60gになるよう設計してある。この結果,接 点材をエアブロー等のクリーニング併用で繰り返し再現性± 0.1dB,耐久性30万回以上を実現できた。寿命試験結果を図4 に示す。

(3)狭ピッチ対応

ME0100シリーズの接点部構造は,板厚: 0.3mm,板幅: 1.2mmのセラミックを用いた片持ちばね方式となっており, 対応可能なデバイスピッチは1.27mm以上である。0.5mmピッ チまで対応させるためセラミックの板幅を0.3mmにすると, 接触安定に必要な接圧を得るためにはセラミックの板厚を厚 くするか、長さを短くしなければならない。ところが、板厚 を厚くするとセラミック基板カットの加工が困難であるとい う問題点があった。長さを短くすると(約20mm 約12mm) しても、Active Device対応で要求される接点部と整合回路ま での距離2mm以下の実現は困難である。

そこで,今回開発した新接点部構造では,セラミックの代 わりにポリイミドシートを使用し,デバイス端子との接触部 には接点材を固着している。ポリイミドシートはセラミック に比べ加工性が良く,例えば0.5mm ピッチでスリットをいれ る加工(測定再現性を向上させるため,接点部の個別動作に 必要な加工)も可能である。

このポリイミドシートを採用することで,接点部幅を 0.3mmとすることができ,0.5mmピッチのデバイス対応が可 能となった。

また,ポリイミドシート厚を0.125mm,長さを2.3mm,最 大たわみを0.4mmとすることで接圧30gを得ることができる。 この時の設計最大応力は約15kg/mm²で,ポリイミドシート の許容曲げ応力を十分満足しており,実験においても図4の 寿命試験結果に示すように100万回の機械的寿命を確認してい る。以下に設計式とポリイミドシートの主な機械的特性を示す。

- W = bh ² /6L
 - = 2L² /3hE

ただし

- W :接圧
 - :最大たわみ



- :許容曲げ応力
- E:縱弾性係数
- b:シート幅
- h:シート厚
- L:シート長さ
- ポリイミドシートの主な機械的特性
- **縦弾性係数:** 338 kg/mm²
- 許容曲げ応力: 20 kg/mm²
- (4) メンテナンス性

テストフィクスチャの接点材は消耗品であるため,寿命時 に交換しなければならない。今回開発した新接点部構造では, この接点材と絶縁シートが一体化され接点シートとなってい るため,この接点シートの交換になる。接点シートには,位 置決めピン用のガイド穴が設けられているため,簡単に位置



精度が決まり交換再現性を良好なものにしている。交換再現 性結果を図5に示す。

また,テストフィクスチャ本体にも位置決めピン用のガイ ド穴を設けているため,測定対象デバイスの品種交換時にも 容易にテストフィクスチャの交換ができ,かつ交換再現性も 良好である。

(5) 高周波特性

周波数範囲をDC~8GHz とするため,高周波伝送線路はマ イクロストリップラインとし,かつライン幅を0.53mmとなる よう高誘電率プリント板を用いた。プリント板パターンと接 点材の接触部はパターン幅が狭くなっており,狭ピッチ対応 ができると共に接点材のインピーダンス補正を行うようにな っている。また,伝送線路は不連続部分をできるだけ少なく なるように考慮した。不連続部は入出力コネクタとプリント 板の接続部,プリント板と接点材の接続部の2ヶ所とし構造の 簡素化を図った。この構造は,顧客の評価基板に近いものと



なり顧客データとのデータ相関が得やすいという効果も得られている。高周波特性結果を図6に示す。また,プリント板





Time domain data of MU740000 test fixture

のパターン幅とインピーダンスのシミュレーション結果を図7

に,タイムドメインでの実測結果を図8に示す。

(6) ユーザエバレーション

試作テストフィクスチャによる Power Amp 評価のユーザー エバレーションを実施した。表4 に Power Amp デバイスの測 定値及び繰り返し再現性の評価結果を示す。

測定値はユーザ治具による測定値との相関性を検証でき,

表4	ユーザエバレーション結果
	User evaluation

パワーアンプ測定値と繰り返し再現性

	項	目	出力電力 1 (dBm)	出力電力 2 (dBm)	動作電流 1 (mA)	動作電流 2 (Am)
測	定	値	31.02	29.83	65.7	540.0
繰り	返し再現	.性(2)	0.06	0.06	9.2	4.0

繰り返し再現性は出力電力において ± 0.06dB で目標規格 ± 0.1dB 以内に収まっていることが確認できた。

また,テストフィクスチャのグランド規格が必要だという 指摘があり,開発当初規格として考えていなかった対グラン ドクロストーク規格を追加することになった。これは,デバ イスと同形状のショートキットを装着したときの伝送特性 (S21)を測定するものである。規格値はユーザーのこれまで の経験や測定デバイス評価上で,最低限必要となる値などを もとに,-30dB/8GHz(グランド端子12本時)とした。新接 点部構造を採用する前の試作品では,グランドまでの距離が 遠く,グランドピン12本時に-15dB/8GHzの性能であったが, 新接点部構造の採用後にはグランドとの接続距離が短くでき るようになり,-36dB/8GHzを実現できた。グランド端子数 と対グランドクロストークの関係を図9に示す。

ポリイミドシートを使った接点シートについても柔らかい 材質上,横変形の問題が生じた。この対策は接点シートのス リット間に絶縁物のガイドを設けることにより解決すること ができた。また,入出力コネクタの中心導体をプリント板パ ターンに接続する方法として,中心導体を押し付ける方法を



図9 グランド端子数とグランドクロストーク Ground cross-talk for the number of ground terminal

採用していたが,信頼性に難があることが判明し,ハンダ付 け方式に変更して信頼性の向上を図ることができた。

表5 MU740000テストフィクスチャ主要規格 Specification of MU740000 test fixture

仕様

項目	仕様	備考
使用周波数	DC ~ 8GHz	移動体デバイス
装着再現性(S21)	± 0.1dB / 8GHz	(注1)
寿命(参考値)	30万回	(注2)
クロストーク(対向)	50dB / 2GHz 30dB / 8GHz	対向距離2.3mm時 先端オープン
クロストーク(隣接)	15dB / ピッチ0.5mm 20dB / ピッチ0.65mm	2GHzでのTypcal値
クロストーク(対グランド)	45dB / 2GHz 30dB / 8GHz	グランド端子12本時 (注3)
挿入損失(参考値)	0.5dB / 2GHz 1.5dB / 8GHz	(注4)
リターンロス(参考値)	20dB / 2GHz 15dB / 8GHz	(注4)

校正条件:コネクタ端でFULL2ポート校正

(注1) デバイスと同形状のスルーを10回リプレース(装着位置は不変)したときの再現性

(注2)実験室レベル。クリーニング併用。初期の挿入損失に対し0.1dB増加,または瞬時再現性(10回測定の2) が0.1dBを超えたとき寿命とみなす。デバイスと同形状のスルーキットにより評価

(注3)ショートキット装着したときのS21を測定

(注4)評価用基板(L=20mm)を2枚使用しデバイスのかわりにスルー基板(L=3mm)を装着したときの値

4_{主要規格}

MU740000シリーズ テストフィクスチャの主要規格を表5 に示す。

う 応用例

ディジタル移動通信器では、RFフィルタ、IFフィルタ、デ ュプレクサのようなフィルタ、直行変調器、出力アンプ、 RF/IFアンプ等の高周波ICなどの部品が使われる。これら部 品試験の量産用には、搬送装置・測定器・テストフィクスチ ャ等で構成されるシステム装置を必要とする。以下にその応 用例を示す。

(1) SAW フィルタ試験装置

ME7860A ギガロボシステムは ME7460A ギガロボJr, MS4662A, NWA, ME0101A テストフィクスチャで構成され たSAW フィルタ試験装置でシステムブロックを図10 に示す。

ME7460A ギガロボJr は搬送装置で,主要規格を表6に示す。 このシステムで800MHz 帯SAW フィルタの挿入損失,反射 減衰量,帯域外減衰量を測定した繰り返し再現性を表7に示

ME7460A GIGAROBO Jr. X軸ロボット(搬送部・位置決め機構部付き) X軸ロボット コントローラ ハンド 操作トレ 不良品 不良品 不良品 不良品 TF 揭 (Y軸) 回収 スイッチ 回収 回収 回収 シーケンス NWA ME0101A PIO MS4662A

図10 ME7860A GIGAROBO システムプロック図 System block diagram of ME7860A GIGAROBO system

(2) RF アンプ試験装置

ME1621B ギガロボ, ME5623A プリアンプ自動測定装置, ME0104A テストフィクスチャで構成されたシステム装置のシ ステムプロックを図11 に示す。

ME1621Bおよび ME5623A の主要規格を表8と表9に示す。 このシステム装置で800 MHz帯プリアンプの出力電力,利

す。

表6 ME7460A/B/C/D ギガロボJr.の主要規格 Specification of ME7460A/B/C/D GIGAROBO Jr.

仕様

項目	ME7460A	ME7460B	ME7460C	ME7460D
メカインデックス	3.5秒/個	4秒 /	個* 2	3.5秒/個
供給	マガジン	/トレー*1	トレー段積み*2	パーツフィーダ*1
良品選別	良品1(トレー)			良品1(BOX)
不良品選別	不良品4(BOX)			不良品4(BOX)
測定ステージ	1	2	2	1
品種対応	1品種但し段取り替えにより多品種対応可			
外 形	1,100W × 840D × 1,500H ^{* 2}			
動 力 源	電源AC100V,800VA,空気源0.4~0.55MPa ^{* 2}			

*1:マガジン,トレー,パーツフィーダは個別仕様になります。

*2:個別仕様書により変更になる場合があります。

表7 ME7860A ギガロボシステム測定再現性

Repeatability of measurement using ME7860A GIGAROBO system

測定再現性例

ME7460A, MS4662AおよびME0101Aでシステムアップし, 800MHz帯SAWフィルタを20回測定したときの再現性データ。

再現性データ(代表例)

		挿入損失	リターンロス	減 衰 域
測定	值(dB)	2.52	9.47	37.74
2	(dB)	0.009	0.022	0.033

サンプルデバイス:800MHz帯SAWフィルタ 端子金メッキ

表8 ME1621B ギガロボの主要規格 Specification of ME1621B GIGAROBO

仕様

項目	ME1621B
メカインデックス	1.7秒/個以下*1
供給	パーツフィーダ*1
良品選別	良品1ランク(BOX回収)
不良品選別	不良品9ランク (BOX)
搬送方式	バキューム2個搬送
測定ステージ	1ステージ(2個同時測定)*1
品種対応	1品種但し、段取り替えにより多品種対応可
外 形	1,360W × 910D × 1,450H *1
	電 源 AC100V,1.5kVA以下
	空気源 0.4MPa~0.5MPa
	真空源 570mmHgG以上

*1:詳細は個別仕様による



図11 RFアンプ試験装置

Block diagram of RF-Amplifier test system

表9 ME5623A プリアンプ自動測定システム主要規格

Specification of ME5623A Pre-Amplifier measurement system

項目	
試験周波数	800 ~ 2,000MHz
利得	測定ダイナミックレンジ:50.0dB 測 定 分 解 能:0.01dB
動作電流	電 流 測 定 範 囲:1.0~200.0mA
入力リタンロス	測定ダイナミックレンジ:50.0dB 測 定 分 解 能:0.01dB
測定時	約880msec 測定周波数:1ポイント 測 定 項 目:利得 ,リタンロス 動作電流(3CH)
システム機能 測定条件入力機能 校正機能 測定機能 測定結果判定機能 測定結果データ出力機能 測定結果データ保存機能	
外形寸法	180H × 550W × 700D m

表10 RFアンプ試験装置測定再現性

Repeatability of measurement using RF-Amplifier test system

測定再現性例

ME1621BギガロボとME0104AテストフィクスチャおよびME5623Aプリアンプ自動測定システムを システムアップし,800MHzプリアンプを10回測定した時の再現性データ。

	出力電圧 (dB)	利 得 (dB)	動作電流 Idd1(mA)	動作電流 Idd2(mA)	リターンロス (dB)
測定値	- 1.22	18.78	13.097	23.195	- 10.647
2	0.03	0.03	0.005	0.024	0.003

得,動作電流,反射減衰量を測定した繰り返し再現性を表10 に示す。

繰り返し再現性結果は,ここで掲げた2つの装置ともユーザ ーの要求を十分満足するものであった。

参考文献

- 1) 鈴木ほか:トータルサービスを提供する高周波デバイス自動検査シ ステムME1621A,アンリツテクニカル,66号(1993.9)
- 2) 中津川ほか:ディジタル移動通信用測定器,アンリツテクニカル, 66号(1993.9)

6 **v**fv

新接点部構造で,繰り返し再現性・耐久性に優れたSSOP対応の高周波テストフィクスチャが実現できた。今後は,表面 実装用の開発およびCSP,ベアチップとさらに小型化するデ バイス用の開発と,mm波までの周波数拡大したテストフィ クスチャの開発を進めていく考えである。